



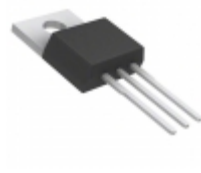

	<h2 style="color: red;">FQP10N60C</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP10N60C</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP10N60C.pdf</a> <a href="#">2.FQP10N60C.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32233 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP10N60C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32233 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 9.5A (Tc) 156W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	156W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	730 mOhm @ 4.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2040pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP10N60C ist neu im Original, Suche FQP10N60C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP10N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP10N60C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FQP10N60CF</b> VB FQP10N60CF VB	 <b>FQP10N65</b> FSC FQP10N65 FSC	 <b>FQP10N60B</b> FAIRCHILD FQP10N60B FAIRCHILD	 <b>FQP10N60C_07</b> VB FQP10N60C_07 VB
 <b>FQP10N65C</b> VB FQP10N65C VB	 <b>FQP10N60C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220	 <b>FQP10N50CF</b> FSC FQP10N50CF FSC	 <b>FQP10N20L</b> VB FQP10N20L VB

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP10N20	↔ FQP10N20	⇒ FQP10N20C	D FQP10N20C	⇒ FQP10N20L
⊕ FQP10N60B	⊗ FQP10N60C	D FQP10N60CF	⇒ FQP10N60C_07	⇒ FQP10N65
⊗ FQP10N65C	⊕ FQP10N80	⊗ FQP11N40C	↔ FQP11N40C	⇒ FQP11N50CF
D FQP11N50CF	⊗ FQP11N60	⊕ FQP11N60C	⊗ FQP11N65C	⇒ FQP11P06
⇒ FQP11P06	↔ FQP12N20	⊗ FQP12N60	⊕ FQP12N60	⇒ FQP12N60C
↔ FQP12N60C	⇒ FQP12N65C	D FQP12P10	⊗ FQP12P10	⊕ FQP12P20
⊗ FQP12P20	D FQP13N06	⇒ FQP13N06	↔ FQP13N06L	⇒ FQP13N06L
⊕ FQP13N10	⊗ FQP13N10	↔ FQP13N10L	⇒ FQP13N10L	⇒ FQP13N50
⊗ FQP13N50	⊕ FQP13N50C	⊗ FQP13N50C	D FQP13N60C	⇒ FQP140N03
↔ FQP140N03L	⊗ FQP14N15	⊕ FQP14N15	⊗ FQP14N30	⇒ FQP14N30

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited